

## Description

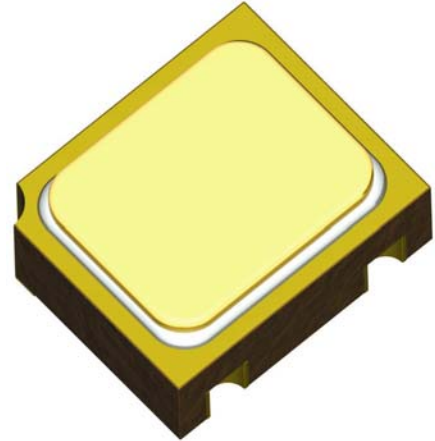
SEMICOA offers:

- Screening and processing per MIL-PRF-19500 Appendix E
- JAN level (2N4261UBJ)
- JANTX level (2N4261UBJX)
- JANTXV level (2N4261UBJV)
- JANS level (2N4261UBJS)
- QCI to the applicable level
- 100% die visual inspection per MIL-STD-750 method 2072 for JANTXV and JANS
- Radiation testing (total dose) upon request

Please contact SEMICOA for special configurations  
[www.SEMICOA.com](http://www.SEMICOA.com) or (714) 979-1900

## Applications

- General purpose switching transistor
- Low power
- PNP silicon transistor



## Features

- Hermetically sealed Cersot ceramic
- Also available in chip configuration
- Chip geometry 0014
- Reference document: MIL-PRF-19500/511

## Benefits

- Qualification Levels: JAN, JANTX, JANTXV and JANS
- Radiation testing available

Absolute Maximum Ratings		T <sub>C</sub> = 25°C unless otherwise specified	
Parameter	Symbol	Rating	Unit
Collector-Emitter Voltage	V <sub>CEO</sub>	15	Volts
Collector-Base Voltage	V <sub>CBO</sub>	15	Volts
Emitter-Base Voltage	V <sub>EBO</sub>	4.5	Volts
Collector Current, Continuous	I <sub>C</sub>	30	mA
Power Dissipation, T <sub>A</sub> = 25°C Derate linearly above 25°C	P <sub>T</sub>	200 1.14	mW mW/°C
Thermal Resistance	R <sub>θJA</sub>	0.86	°C/mW
Operating Junction Temperature Storage Temperature	T <sub>J</sub> T <sub>STG</sub>	-65 to +200	°C

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

characteristics specified at  $T_A = 25^\circ\text{C}$

Off Characteristics						
Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10\text{ mA}$	15			Volts
Collector-Base Cutoff Current	$I_{CBO}$	$V_{CB} = 15\text{ Volts}$			10	$\mu\text{A}$
Collector-Emitter Cutoff Current	$I_{CEX1}$	$V_{CE} = 10\text{ Volts}, V_{BE} = 0.4\text{ Volts}$			50	nA
	$I_{CEX2}$	$V_{CE} = 10\text{ Volts}, V_{BE} = 2\text{ Volts}$			5	nA
	$I_{CEX3}$	$V_{CE} = 10\text{ Volts}, V_{BE} = 2\text{ Volts}, T_A = 150^\circ\text{C}$			5	$\mu\text{A}$
Emitter-Base Cutoff Current	$I_{EBX}$	$V_{BE} = 2\text{ Volts}, V_{CE} = 10\text{ Volts}$			5	nA
Emitter-Base Cutoff Current	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 4.5\text{ Volts}$			10	$\mu\text{A}$

On Characteristics			Pulse Test: Pulse Width = 300 $\mu\text{s}$ , Duty Cycle $\leq 2.0\%$			
Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
DC Current Gain	$h_{FE1}$	$I_C = 1\text{ mA}, V_{CE} = 1\text{ Volts}$	25			
	$h_{FE2}$	$I_C = 10\text{ mA}, V_{CE} = 1\text{ Volts}$	30		150	
	$h_{FE3}$	$I_C = 30\text{ mA}, V_{CE} = 1\text{ Volts}$	20			
	$h_{FE4}$	$I_C = 10\text{ mA}, V_{CE} = 1\text{ Volts}, T_A = -55^\circ\text{C}$	15			
Base-Emitter Voltage	$V_{BE1}$	$V_{CE} = 1\text{ Volts}, I_C = 1\text{ mA}$			0.8	Volts
	$V_{BE2}$	$V_{CE} = 1\text{ Volts}, I_C = 10\text{ mA}$			1.0	
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CEsat1}$	$I_C = 1\text{ mA}, I_B = 0.1\text{ mA}$			0.15	Volts
	$V_{CEsat2}$	$I_C = 10\text{ mA}, I_B = 1\text{ mA}$			0.35	

Dynamic Characteristics						
Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Magnitude – Common Emitter, Short Circuit Forward Current Transfer Ratio	$ h_{FE1} $	$f = 100\text{ MHz}, V_{CE} = 4\text{ Volts}, I_C = 5\text{ mA}$	15			
	$ h_{FE2} $	$V_{CE} = 10\text{ Volts}, I_C = 10\text{ mA}$	20			
Open Circuit Output Capacitance	$C_{OBO}$	$V_{CB} = 4\text{ Volts}, I_E = 0\text{ mA}, 100\text{ kHz} < f < 1\text{ MHz}$			2.5	pF
Open Circuit Input Capacitance	$C_{IBO}$	$V_{EB} = 0.5\text{ Volts}, I_C = 0\text{ mA}, 100\text{ kHz} < f < 1\text{ MHz}$			2.5	pF
Collector Base time constant	$r_b' C_{C1}$	$V_{CE} = 4\text{ Volts}, f = 31.8\text{ MHz}, I_C = 5\text{ mA}$			60	ps
	$r_b' C_{C2}$	$I_C = 10\text{ mA}$			50	

Switching Characteristics						
Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Saturated Turn-On Time	$t_{ON}$	$V_{CC} = 17\text{ Volts}, I_C = 10\text{ mA}$			2.5	ns
Saturated Turn-Off Time	$t_{OFF}$	$V_{CC} = 17\text{ Volts}, I_C = 10\text{ mA}$			3.5	ns



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331